

phototransistor NPN



BPX 95 C

Janvier 1982

Phototransistor au silicium, planar épitaxié NPN, en boîtier SOD 63 incolore.

Sa réponse spectrale centrée dans l'infrarouge à 800 nm et s'étendant à mi-sensibilité de 550 à 950 le destine à la détection aussi bien dans le spectre visible que dans le proche infrarouge.

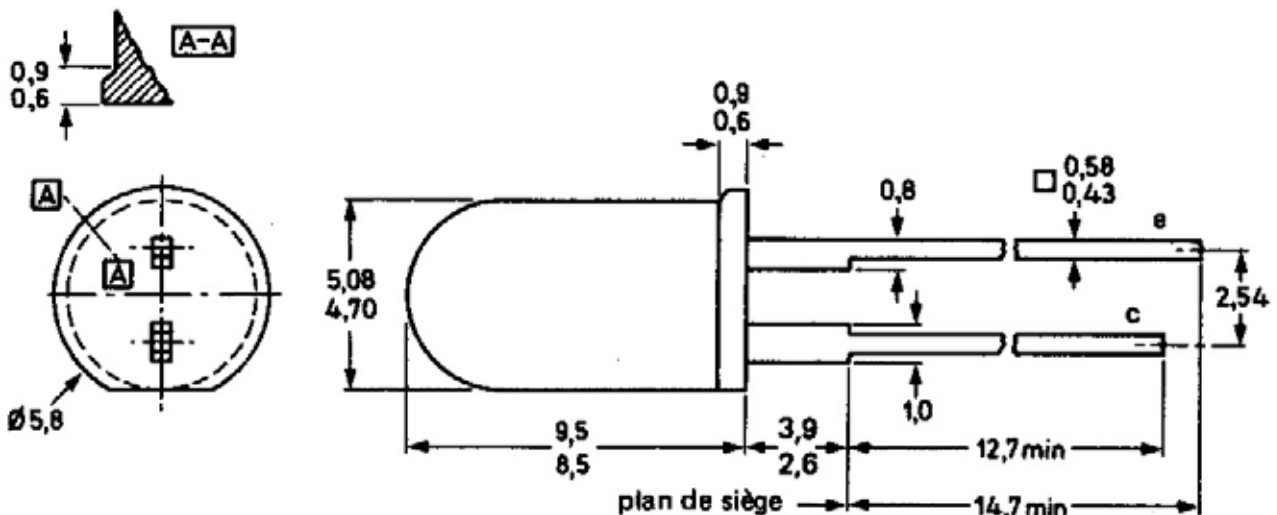
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | | | | |
|---|-------------|-----|----------|------------|
| Tension collecteur-émetteur (base ouverte) | V_{CEO} | max | 30 | V |
| Courant collecteur en continu. | I_C | max | 25 | mA |
| Puissance totale dissipée $T_{amb} \leq 25^\circ C$ | P_{tot} | max | 100 | mW |
| Température de jonction. | T_j | max | 100 | $^\circ C$ |
| Courant collecteur en éclaircissement | | | | |
| $V_{CE} = 5 V$; $E = 1 mW/cm^2$, $\lambda = 930 nm$ | $I_C (L)$ | typ | 9 | mA |
| Longueur d'onde du pic de réponse spectrale | λ_p | typ | 800 | nm |
| Angle de réceptivité. | θ | typ | ± 10 | $^\circ$ |

DONNEES MECANIQUES

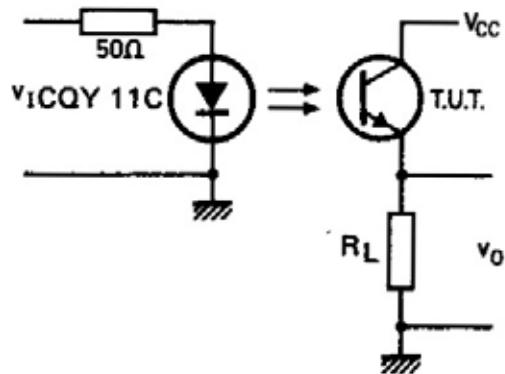
Dimensions en mm

BOITIER SOD 63

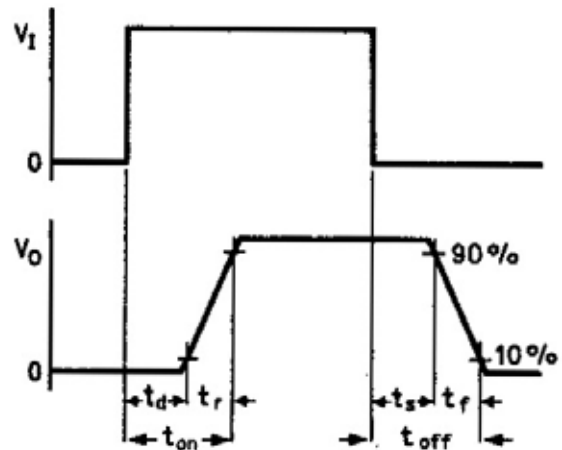


Temps de commutation
 $I_{Con} = 2 \text{ mA} ; V_{CC} = 5 \text{ V} ; R_L = 100 \Omega$

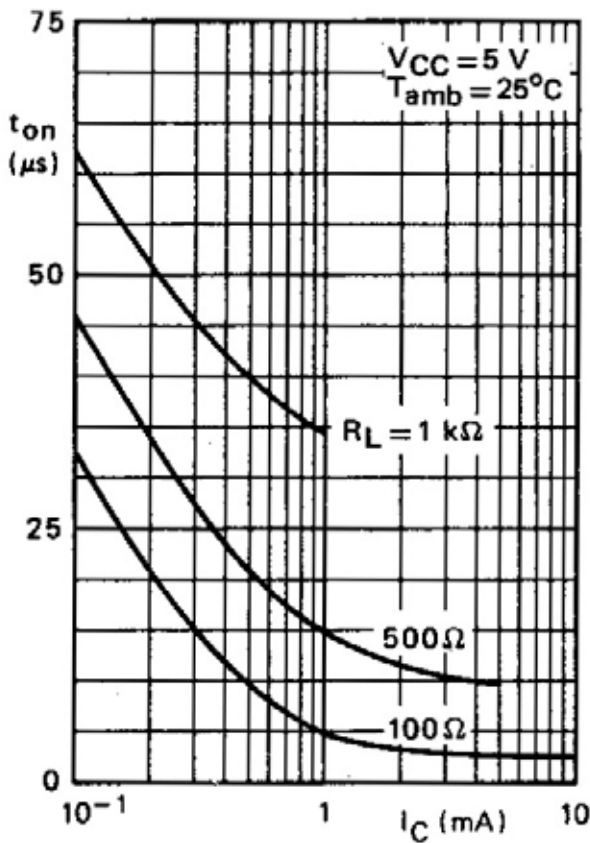
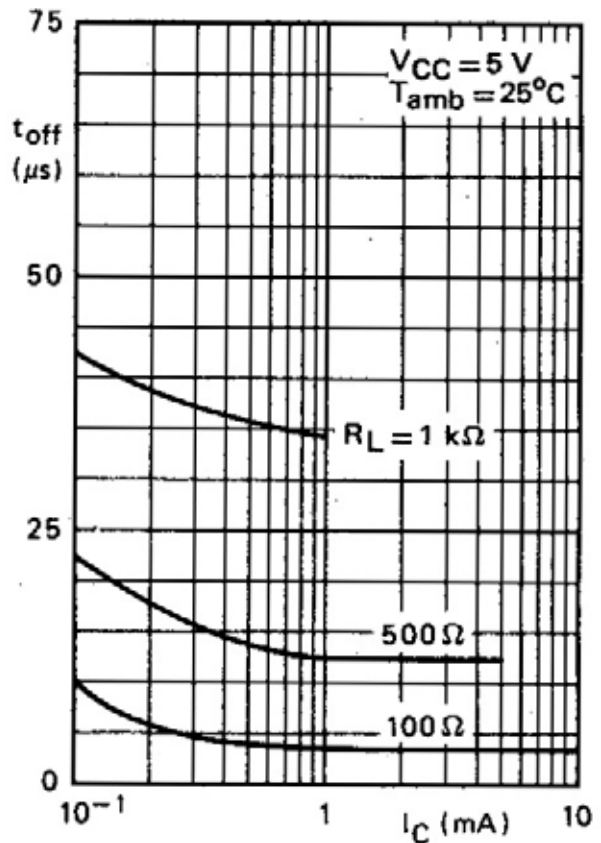
| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----|---|---------------|
| temps total d'établissement | t_{on} | typ | 3 | μs |
| temps total de décroissance | t_{off} | typ | 3 | μs |


Fig. 2

Circuit de mesure des temps de commutation


Fig. 3

Formes d'onde et définition des temps de commutation


Fig. 4

Fig. 5

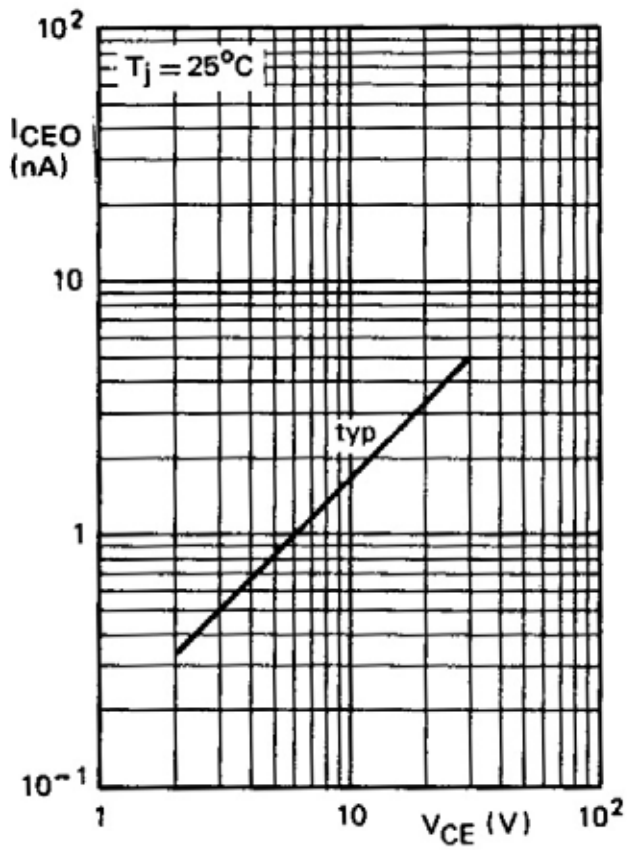


Fig. 6

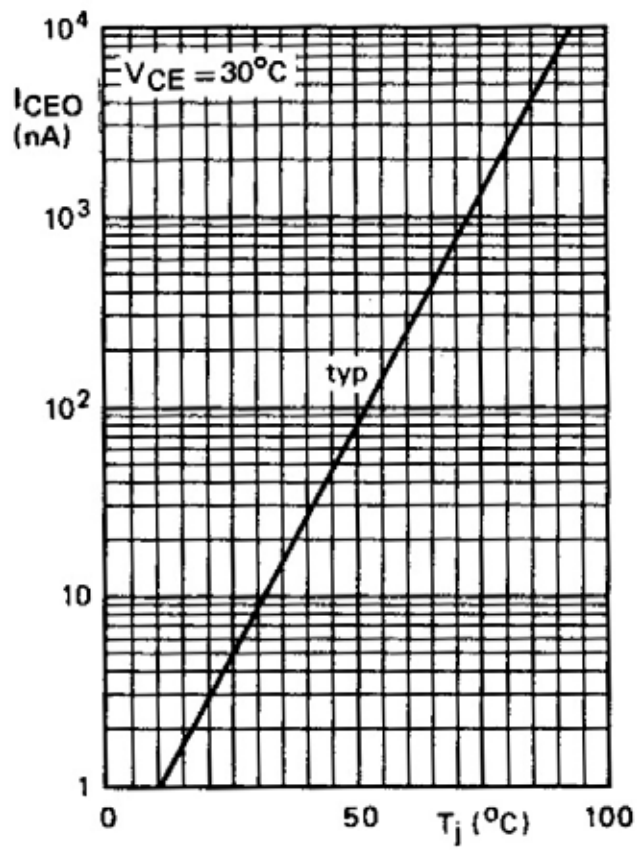


Fig. 7

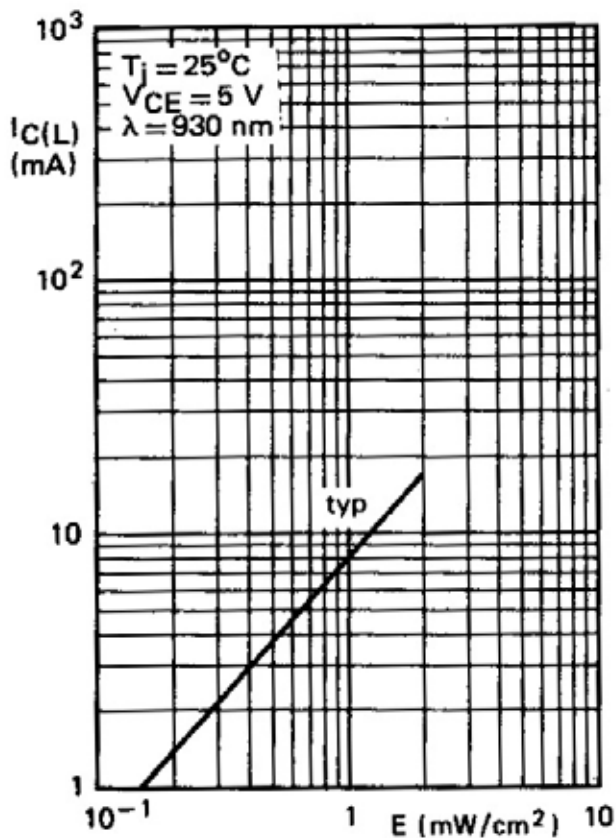


Fig. 8

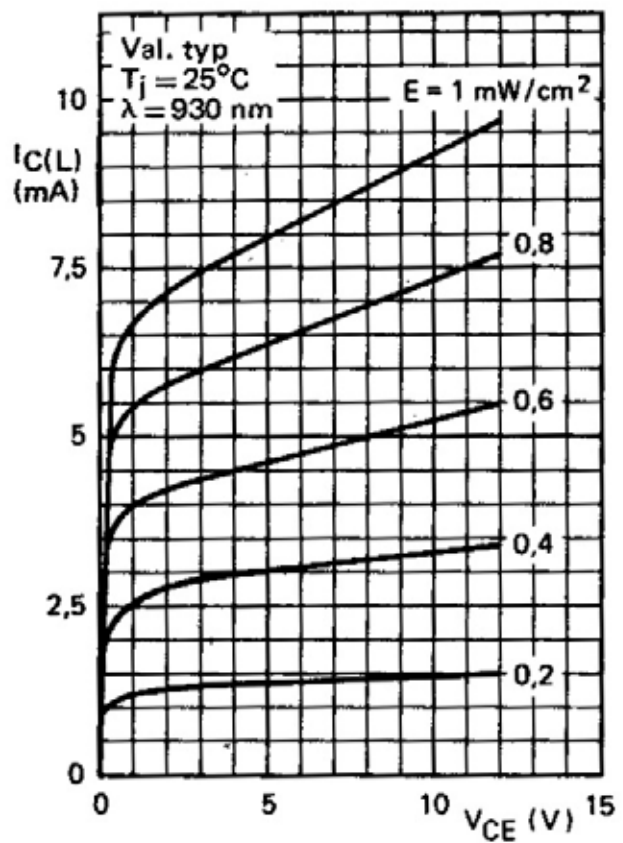


Fig. 9

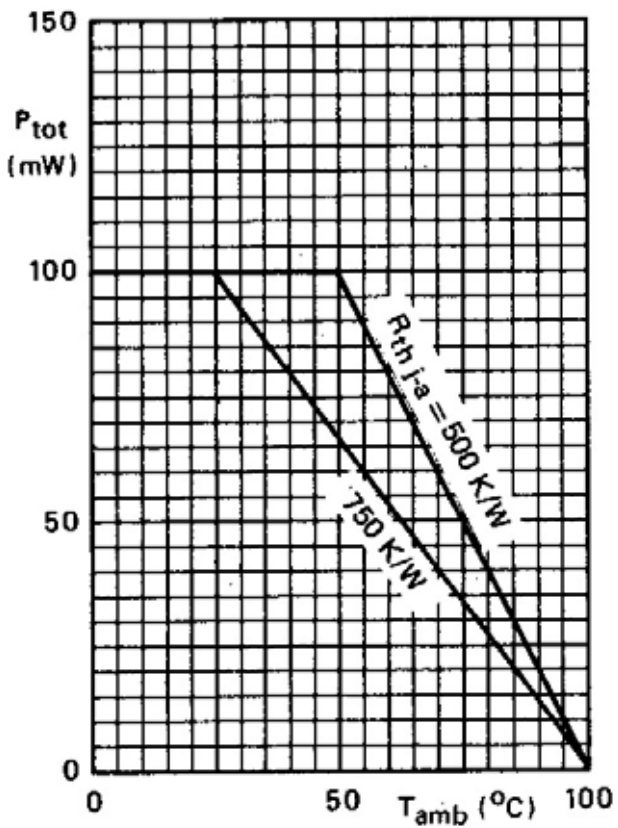


Fig. 10

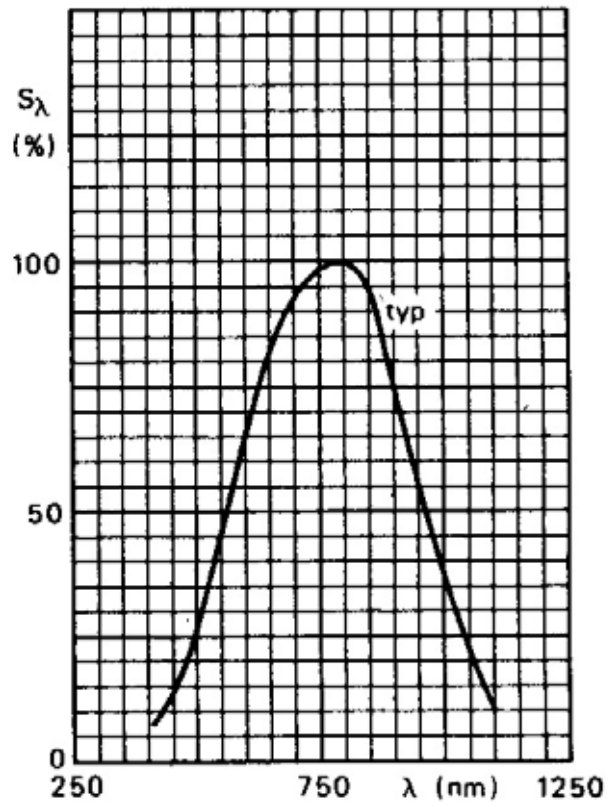


Fig. 11

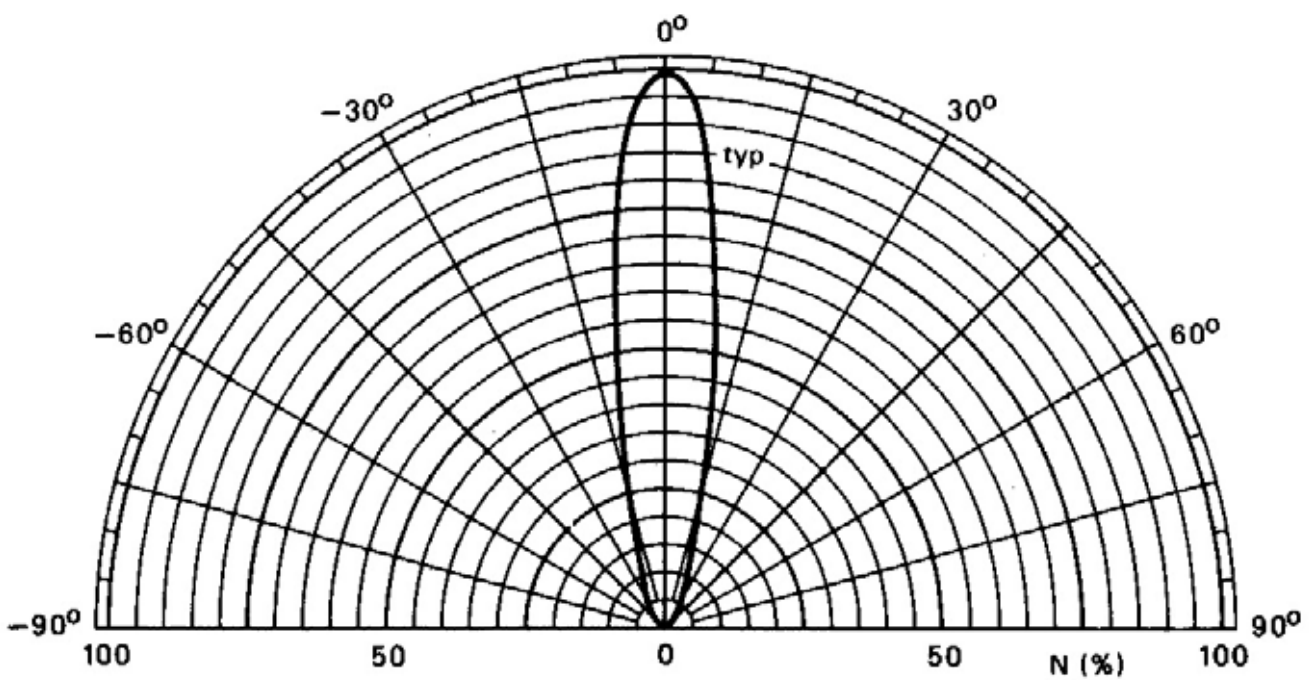


Fig. 12